
	<h2 style="color: red;">FQP6N80</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP6N80</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 5.8A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP6N80.pdf</a> <a href="#">2.FQP6N80.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 37203 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP6N80
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 5.8A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37203 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.95 Ohm @ 2.9A, 10V
Verlustleistung (max)	158W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 5.8A (Tc) 158W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.8A (Tc)

FQP6N80 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP6N80-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP6N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP6N80 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQP6N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.8A TO-220</p>	 <p><b>FQP6N90C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-220</p>	 <p><b>FQP6N70</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A TO-220</p>	 <p><b>FQP6N70</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A TO-220</p>
 <p><b>FQP6N90</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.8A TO-220</p>	 <p><b>FQP6N60C_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP6N80C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP6N80C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP6N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP6N80 Datenblatt	FQP6N80-Datenblätter	FQP6N80 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP6N80
FQP6N80 Electronic	FQP6N80-Komponenten	FQP6N80-Verteiler	FQP6N80-Bild	FQP6N80-Teil
FQP6N80 Preis	FQP6N80 Hersteller	FQP6N80 Bild	FQP6N80 Aktie	FQP6N80 Inventar
FQP6N80 Neu	FQP6N80 Original	FQP6N80 garantiert	FQP6N80 RFQ	FQP6N80 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited